

БКО.347.222-04 ТУ

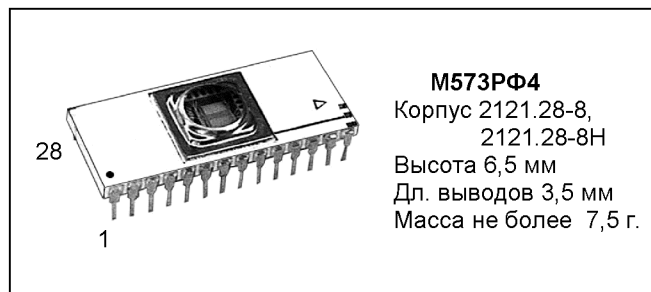
M573PФ4A
M573PФ4Б**64К (8Кx8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ**

NМОП технология

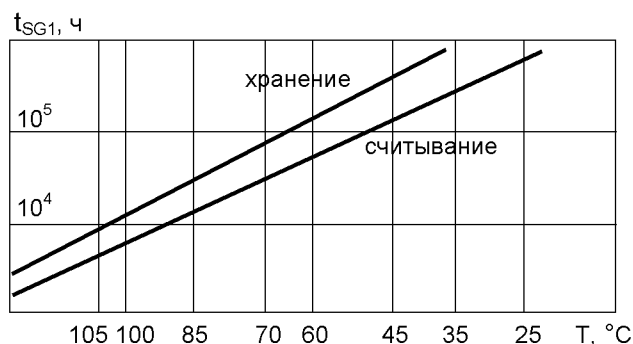
Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность долговременного хранения и многократной смены информации.

Предназначено для построения энергонезависимой памяти микро-ЭВМ, систем сбора и обработки информации, систем промышленной автоматики, связи и измерительной техники.

- время выборки адреса 300нс;
- напряжение питания $5В \pm 10\%$;
- напряжение программирования $21,5В \pm 0,5В$;
- допустимое значение статического потенциала не более 100В.

**НАДЕЖНОСТЬ**

Наработка, ч	$t_{и}$	100 000
Интенсивность отказов 1/ч	$\lambda_{и}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	25

ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ t_{SG1} ОТ T**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

1	U_{PR}	Напряжение программирования
2 -10, 21 23 -25	A12, A7, A6 -A0, A10, A11, A9, A8	Входы адресные
11-13, 15 -19	D0 - D7	Вход-выход
20	\overline{CE}	Вход сигнала разрешения обращения
14	GND	Общий
22	\overline{OE}	Вход сигнала разрешения выхода
26	-	Свободный
27	WR/RD	Вход сигнала записи
28	U_{CC}	Источник питания

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**МЕХАНИЧЕСКИЕ**

Механические удары, g	1500
Линейное ускорение, g	20 000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, g	40
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

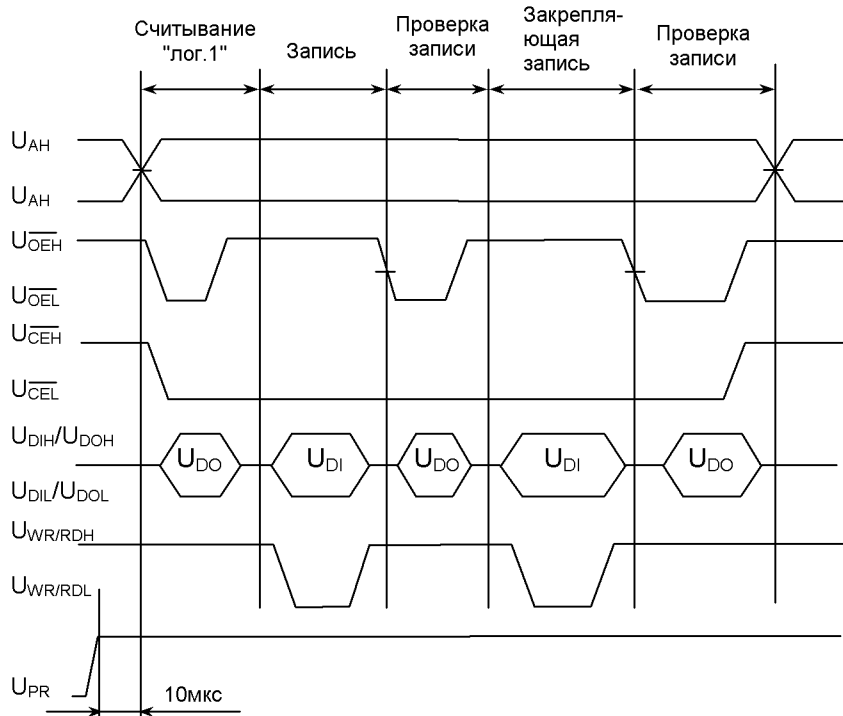
КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °C	от - 60 до 125
Повышенная влажность при T = 35 °C, %	до 98
Температура пайки, °C	235 ± 5
Продолжительность, с	2 ± 0,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$)

Символ	Параметр	T, °C	M573PФ4А	M573PФ4Б
U_{DOL}	Выходное напряжение низкого уровня, В ($I_{OL} = 2,1 \text{ mA}$)	от - 60 до 85	$\leq 0,45$	$\leq 0,45$
U_{DOH}	Выходное напряжение высокого уровня, В ($I_{OH} = 0,4 \text{ mA}$)	от - 60 до 85	$\geq 2,4$	$\geq 2,4$
I_{CC}	Ток потребления, мА	25, 85 - 60	≤ 60 ≤ 70	≤ 60 ≤ 70
I_{PR}	Ток сигнала программирования, мА	25, 85 - 60	≤ 5 ≤ 10	≤ 5 ≤ 10
I_{LI}	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 60 до 85	≤ 10	≤ 10
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,3$	$\leq 0,45$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,3$	$\leq 0,45$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,12$	$\leq 0,15$
t_{SG1}	Время хранения информации при отключённом питании, ч	25, - 60 85	$\geq 100\ 000$ $\geq 25\ 000$	$\geq 100\ 000$ $\geq 25\ 000$
t_{SG2}	Время хранения информации при включённом питании, ч	25, - 60 85	$\geq 50\ 000$ $\geq 10\ 000$	$\geq 50\ 000$ $\geq 10\ 000$
C_I	Входная ёмкость выводов микросхем, пФ	от - 60 до 85	≤ 6	≤ 6
C_{IO}	Входная ёмкость входа-выхода	от - 60 до 85	≤ 12	≤ 12
N_{CY}	Количество циклов перепрограммирования, цикл	25 ± 10	≥ 25	≥ 25

**ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ-СЧИТЫВАНИЯ
(verify)**



Время стирания информации, с.

$$t_{EE} = \frac{H_E}{E_E}$$

где E_E – измеренное значение энергетической освещенности УФ-излучения ($\lambda=253,7 \text{ нм}$) в плоскости окна корпуса микросхемы;
 $H_E = 2 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$ – требуемое значение энергетической экспозиции.

Ток потребления от напряжения программирования (U_{PR}) в момент записи информации достигает 40 мА (импульсный), а в режиме запрета записи не более 5,0 мА.